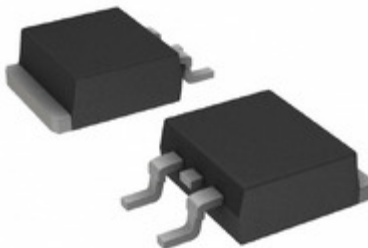









	<p><b>Référence fabricant:</b> <a href="#">FQB8N60CTM</a></p>
	<p><b>Fabricant / Marque:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p>
	<p><b>Une partie de la description:</b> MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK</p>
	<p><b>Livret des spécifications:</b>  <a href="#">FQB8N60CTM.pdf</a></p>
<p><b>Statut RoHS:</b> Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p>	<p><b>État du stock:</b> New original, 9914 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Bateau de:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Manière d'expédition:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Caractéristiques

Modèle de produit	<a href="#">FQB8N60CTM</a>
Fabricant	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
La description	MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK
Catégorie	<a href="#">Produits semi-conducteurs discrets &gt; Transistors - FET,</a>
État de la pièce	9914 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Séries	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3.75A, 10V
Dissipation de puissance (max)	3.13W (Ta), 147W (Tc)
Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Autres noms	FQB8N60CTMFSDKR
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Délai de livraison standard du fabricant	16 Weeks
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	1255pF @ 25V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	10V
Tension drain-source (Vdss)	600V
Description détaillée	N-Channel 600V 7.5A (Tc) 3.13W (Ta), 147W (Tc)
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	7.5A (Tc)

### Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p><b>FQB8N60CS</b> FAIRCHILD FQB8N60CS FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB8N60CF</b> FSC FSC TO-263</p>	 <p><b>FQB8N60CTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A</p>	 <p><b>FQB8N60TM</b> FAI FQB8N60TM FAI</p>
 <p><b>FQB8N60CTM MOS</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO263</p>	 <p><b>FQB8N60CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.26A D2PAK</p>	 <p><b>FQB8N80</b> FAIRCHILD FQB8N80 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB8N60CTM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A</p>

### FQB8N60CTM Mots-clés

Plus

<a href="#">FQB8N60CTM</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">Fiche technique FQB8N60CTM</a>	<a href="#">Fiches techniques FQB8N60CTM</a>	<a href="#">FQB8N60CTM PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB8N60CTM</a>
<a href="#">FQB8N60CTM électronique</a>	<a href="#">Composants FQB8N60CTM</a>	<a href="#">Distributeur FQB8N60CTM</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Image</a>	<a href="#">Action FQB8N60CTM</a>	<a href="#">Partie FQB8N60CTM</a>
<a href="#">Prix FQB8N60CTM</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Fabricant</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Photo</a>	<a href="#">FQB8N60CTM RFQ</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Inventaire</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Commande en ligne</a>
<a href="#">FQB8N60CTM Nouveau</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Original</a>	<a href="#">FQB8N60CTM garanti</a>			

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited